

集成电路散热板用高导热氮化铝陶瓷基板基片、led氮化铝基板

产品名称	集成电路散热板用高导热氮化铝陶瓷基板基片、led氮化铝基板
公司名称	长沙市啟睿新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银杉路31号绿地时代广场1栋408房
联系电话	13365870915

产品详情

氮化铝陶瓷基板、基片

您可能在找：氮化铝陶瓷基板, 氮化铝陶瓷基板哪个公司好, 氮化铝陶瓷基板 厂家, 优惠的氮化铝陶瓷基板, 促销氮化铝陶瓷基板, 氮化铝陶瓷基板的抛光片, 聚晶体氮化铝陶瓷基板, 氮化铝陶瓷基板厂家, 氮化铝陶瓷基板厂商, 氮化铝陶瓷基板价格, 高导热性氮化铝陶瓷基板, 氮化铝陶瓷基板材料, 氮化铝陶瓷覆铜基板, 氮化铝陶瓷基板抛光, 高导热氮化铝陶瓷基片, 氮化铝陶瓷基片, 氮化铝陶瓷基片做集成电路散热板, 抛光氮化铝陶瓷基片, 氮化铝陶瓷基片价格, 氮化铝陶瓷基片生产商, 氮化铝陶瓷基片表面材料, 氮化铝陶瓷基片厂家, 氮化铝基片抛光, 氮化铝单晶基片价格, 氮化铝基片, 求购氮化铝基片, 氮化铝基片价格, 氮化铝划槽基片, 氮化铝单晶基片, 国产氮化铝基片, 氮化铝 led 基板, 氮化铝散热基板, 大尺寸氮化铝基板, 氮化铝基板国产, 供应氮化铝基板, 热压烧结氮化铝基板, 集成电路基板氮化铝, led氮化铝基板, 氮化铝基板价格, 氮化铝基板厂家, 氮化铝基板定制, 氮化铝基板加工, 高频氮化铝基板, 半导体基板材料氮化铝

氮化铝 (AlN) 是共价键化合物, 原子晶体, 属类金刚石氮化物、六方晶系, 纤锌矿型的晶体结构, 无毒, 呈白色或灰白色, 理论密度3.26g/cm³。

氮化铝材料具有如下特性：

- (1)高热导率 (理论值约320W/m · K)；
- (2)高绝缘性；
- (3)低热膨胀系数(4.5×10^{-6})与Si($3.5 \sim 4 \times 10^{-6}$)和GaAs(6×10^{-6})匹配；
- (4)电性能优良(介电常数、介质损耗、体电阻率、介电强度)；
- (5)机械性能好；
- (6)耐腐蚀性好；
- (7)光传输特性好；

氮化铝陶瓷已成为新一代大规模集成电路、半导体模块及大功率器件理想的散热和封装材料，大量应用于HBLED、UVLED封装、大功率集成电路、功率模块、RF射频/微波通讯、汽车电子、微电子半导体、影像传输等领域。

氮化铝陶瓷材料具有优良的热传导性、可靠的电绝缘性、低的介电常数和介电损耗，可用于制造高导热无磁骨架材料、电子基片、微波介电材料、耐高温、绝缘及耐腐蚀结构陶瓷材料制品。氮化铝陶瓷还可用作熔炼有色金属和半导体材料砷化镓的坩埚、蒸发舟、高温绝缘件、微波介电材料、耐高温及耐腐蚀结构陶瓷及透明氮化铝微波陶瓷制品等。

氮化铝陶瓷技术性能参数表一

分类	项目	单位	指标值		
			AN170	AN200	AN220
基本性能	颜色	-	灰色	米色	
	吸水率	%	0		
	体积密度	g/cm ³	3.30	3.23	
	表面粗糙度	m	0.1 ~ 0.6		
	翘曲率	‰	2		
热学性能	热导率 (20)	W/m.k	170	200	220
	热膨胀系数	20 ~ 300 40 ~ 800	× 10 ⁻⁶ / 5.2	4.6	
力学性能	抗弯强度	Mpa	450	300	200

电学性能	弹性模量	Gpa	320	310	
	莫氏硬度	-	8		
	抗电强度	KV/mm	17	16	15
	体积电阻率	.cm	1014	1013	
	介电常数	-	9	8.6	8.5
	介电损耗	$\times 10^{-4}$	2.98	2	

氮化铝陶瓷技术性能参数表二

性能内容	性能指标
体积密度	3.3 g/cm ³
吸水率	0%
热导率 (20)	170W/m · k
线膨胀系数 (RT-400)	$4.4 \times 10^{-6}/$
抗弯强度 (Mpa)	330
体积电阻率	1014 . cm
介电常数 (1MHz)	9.0
介质损耗	3×10^{-4}
抗电强度	15KV/mm
表面粗糙度Ra	0.3 ~ 0.5m (20nm)
翘曲度 (~/25.4 (长度))	0.03 ~ 0.05
外观	致密、细晶